

**Материалы электроники**

Повышение эффективности кремниевых солнечных элементов посредством нанопористого покрытия. *Джафаров Т. Д., Асланов Ш. С., Рагимов Ш. Х., Садыгов М. С., Набиева А. Ф., Айдин Юксел С.* (на английском языке)

2

Фотолюминесцентный метод исследования пластической деформации на границе раздела «SiO<sub>2</sub>—Si». *Кулинич О. А., Яцунский И. Р., Ештокина Т. Ю., Брусенская Г. И., Марчук И. А.*

2

Наноконкомпозиты на основе опаловых матриц с кристаллическими ферротороидальными мультиферроиками. *Самойлович М. И., Ринкевич А. Б., Бовтун В., Белянин А. Ф., Нужный Д., Кемпа М., Цветков М. Ю., Клещева С. М.*

3

Влияние толщины и температуры пленок фталоцианина меди на их свойства. *Алиева Х. С.*

3

Механизм формирования межслоевых квантовых нитей в легированном цинком Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>. *Алиева А. П., Алескеров Ф. К., Кахраманов С. Ш., Насибова С. А., Моройдор Е. Д., Пишкин М.*

3

Широкозонные халькогенидные сцинтилляторы на основе соединений A<sup>II</sup>B<sup>VI</sup>. *Старжинский Н. Г., Гринёв Б. В., Рыжиков В. Д., Малюкин Ю. В., Жуков А. В., Сидлецкий О. Ц., Зеня И. М., Лалаянц А. И.*

4

Прогноз диэлектрических потерь в стеклокерамике для разных соотношений массовых долей компонентов. *Дмитриев М. В., Еримичой И. Н., Панов Л. И.*

4

Гетеропереходы, сформированные отжигом слоистых кристаллов GaSe и InSe в парах цинка. *Кудринский З. Р., Ковалюк З. Д.*

6

Стимулируемая водородом миграция атомов металлов в структурах «металл — полупроводник». *Матюшин В. М., Жавжаров Е. Л.*

6

**Метрология. Стандартизация**

Визуальные и оптико-электронные автоколлиматоры. *Фесенко А. В., Боровицкий В. Н.*

6

**Библиография**

Указатель статей, опубликованных в журнале в 2011 г.

1

**РЕЦЕНЗЕНТЫ НОМЕРА**

*Дмитрук Николай Леонтьевич*, докт. физ.-мат. наук, профессор, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва НАНУ, г. Киев

*Добровольский Юрий Георгиевич*, канд. техн. наук, начальник научно-аналитического отдела, Научно-производственная фирма «Тензор», г. Черновцы

*Иващук Анатолий Васильевич*, канд. техн. наук, зам. директора научно-учебного центра «Наноэлектроника и нанотехнологии», доцент, НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев

*Кондрик Александр Иванович*, ведущий инженер-исследователь, ННЦ «Харьковский физико-технический институт», г. Харьков

*Круковский Семен Иванович*, докт. техн. наук, начальник сектора, НПП «Карат», г. Львов

*Кудрик Ярослав Ярославович*, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва НАНУ, г. Киев

*Николаенко Юрий Егорович*, докт. техн. наук, ведущий научный сотрудник, НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев

*Рюхтин Вячеслав Васильевич*, канд. техн. наук, зам. председателя правления по научной работе, ЦКБ «Ритм», г. Черновцы

*Старжинский Николай Григорьевич*, докт. техн. наук, ведущий научный сотрудник Института сцинтилляционных материалов НАНУ, г. Харьков

*Старостенко Владимир Викторович*, докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой, профессор, Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, г. Симферополь

*Трофимов Владимир Евгеньевич*, канд. тех. наук, доцент, Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса